Catalogue produits

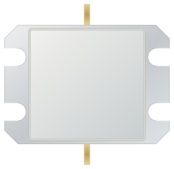
Transistors de puissance RF

Les transistors de puissance RF transforment la polarisation et le signal d'attaque en puissance de sortie d'amplificateur. Ils sont utilisés dans les chaînes d'émission, modules de puissance RF, équipements industriels et bancs de test forte puissance.



Produits: 11

Révision: 10 · Date de révision: 2026-11-11



LCT-5700-7100-PS51T

5700–7100 MHz GaN Transistor de puissance à adaptation interne — PSAT 51 dBm (typique)

5700–7100 MHz; PSAT 51 dBm (typique); Gain en puissance 11 dB (typique); PAE 45 % (typique).

Fréquence de fonctionnement: Symbole: f; Minimum: 5700; Maximum: 7100; Valeur: 5700–7100; Unité: MHz

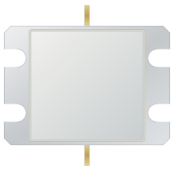
Puissance de sortie saturée: Minimum: 50.5; Typique: 51; Unité: dBm

Gain en puissance: Minimum: 10.5; Typique: 11; Unité: dB

Rendement en puissance ajoutée: Minimum: 40; Typique: 45; Unité: %

TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS ∈ [-3.2, -2.4] V; Pin = 40 dBm; D = 10%; PW = 100 µs

Détails du produit Fiche technique produit



LCT-2700-3500-PS56p5T

2700–3500 MHz GaN Transistor de puissance à adaptation interne — PSAT 56.5 dBm (typique)

2700–3500 MHz; PSAT 56.5 dBm (typique); Gain en puissance 13.5 dB (typique); PAE 55 % (typique).

Fréquence de fonctionnement: Symbole: f; Minimum: 2700; Maximum: 3500; Valeur: 2700–3500; Unité: MHz

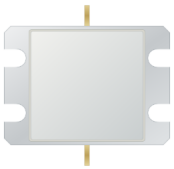
Puissance de sortie saturée: Minimum: 56; Typique: 56.5; Unité: dBm

Gain en puissance: Minimum: 13; Typique: 13.5; Unité: dB

Rendement en puissance ajoutée: Minimum: 50; Typique: 55; Unité: %

TA = +25 °C; VDS = 44 V; VGS ∈ [-4, -2] V; IDS = (0.2–0.5) IDSS; PW = 300 µs; D = 10%

Détails du produit Fiche technique produit



LCT-5300-5900-PS56p5T

5300–5900 MHz GaN Transistor de puissance à adaptation interne — PSAT 56.5 dBm (typique)

5300–5900 MHz; PSAT 56.5 dBm (typique); Gain en puissance 12.5 dB (typique); PAE 45 % (typique).

Fréquence de fonctionnement: Symbole: f; Minimum: 5300; Maximum: 5900; Valeur: 5300–5900; Unité: MHz

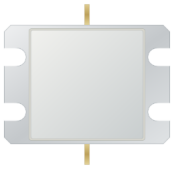
Puissance de sortie saturée: Minimum: 56; Typique: 56.5; Unité: dBm

Gain en puissance: Minimum: 12; Typique: 12.5; Unité: dB

Rendement en puissance ajoutée: Minimum: 40; Typique: 45; Unité: %

TA = +25 °C; VDS = 40 V; VGS ∈ [-4, -2] V; IDS = (0.2–0.5) IDSS; PW = 10 µs; D = 1%

Détails du produit Fiche technique produit



LCT-2700-3900-PS48p5T

2700–3900 MHz GaN Transistor de puissance à adaptation interne — PSAT 48.5 dBm (typique)

2700–3900 MHz; PSAT 48.5 dBm (typique); Gain en puissance 12.5 dB (typique); PAE 50 % (typique).

Fréquence de fonctionnement: Symbole: f; Minimum: 2700; Maximum: 3900; Valeur: 2700–3900; Unité: MHz

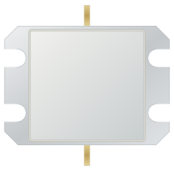
Puissance de sortie saturée: Minimum: 48; Typique: 48.5; Unité: dBm

Gain en puissance: Minimum: 12; Typique: 12.5; Unité: dB

Rendement en puissance ajoutée: Minimum: 45; Typique: 50; Unité: %

TA = +25 °C; VDS = 24–28 V; VGS ∈ [-4, -2] V; IDS = (0.2–0.5) IDSS

Détails du produit Fiche technique produit



LCT-2700-3500-PS53p5T

2700–3500 MHz GaN Transistor de puissance à adaptation interne — PSAT 53.5 dBm (typique)

2700–3500 MHz; PSAT 53.5 dBm (typique); Gain en puissance 13.5 dB (typique); PAE 65 % (typique).

Fréquence de fonctionnement: Symbole: f; Minimum: 2700; Maximum: 3500; Valeur: 2700–3500; Unité: MHz

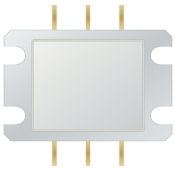
Puissance de sortie saturée: Minimum: 53; Typique: 53.5; Unité: dBm

Gain en puissance: Minimum: 13; Typique: 13.5; Unité: dB

Rendement en puissance ajoutée: Minimum: 60; Typique: 65; Unité: %

TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS ∈ [-4, -2] V; Pin = 40 dBm; D = 10%; PW = 100 µs

Détails du produit Fiche technique produit



LCT-2300-3900-PS50T

2300–3900 MHz GaN Transistor de puissance à adaptation interne — PSAT 50 dBm (typique)

2300–3900 MHz; PSAT 50 dBm (typique); Gain en puissance 12 dB (typique); PAE 50 % (typique).

Fréquence de fonctionnement: Symbole: f; Minimum: 2300; Maximum: 3900; Valeur: 2300–3900; Unité: MHz

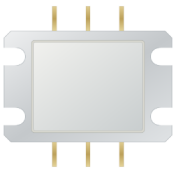
Puissance de sortie saturée: Minimum: 49; Typique: 50; Unité: dBm

Gain en puissance: Minimum: 11; Typique: 12; Unité: dB

Rendement en puissance ajoutée: Minimum: 45; Typique: 50; Unité: %

TA = +25 °C; VGS ∈ [-4, -2] V; VDS = 24–28 V; IDS = (0.2–0.5) IDSS

Détails du produit Fiche technique produit



LCT-2600-3700-PS49T

2600–3700 MHz GaN Transistor de puissance à adaptation interne — PSAT 49 dBm (typique)

2600–3700 MHz; PSAT 49 dBm (typique); Gain en puissance 13 dB (typique); PAE 50 % (typique).

Fréquence de fonctionnement: Symbole: f; Minimum: 2600; Maximum: 3700; Valeur: 2600–3700; Unité: MHz

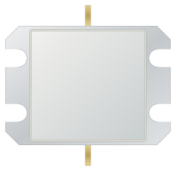
Puissance de sortie saturée: Minimum: 48; Typique: 49; Unité: dBm

Gain en puissance: Minimum: 12; Typique: 13; Unité: dB

Rendement en puissance ajoutée: Minimum: 45; Typique: 50; Unité: %

TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS ∈ [-3.2, -2.2] V; Pin = 36 dBm; CW

Détails du produit Fiche technique produit



LCT-8500-9600-PS51T

8500–9600 MHz GaN Transistor de puissance à adaptation interne — PSAT 51 dBm (typique)

8500–9600 MHz; PSAT 51 dBm (typique); Gain en puissance 9 dB (typique); PAE 38 % (typique).

Fréquence de fonctionnement: Symbole: f; Minimum: 8500; Maximum: 9600; Valeur: 8500–9600; Unité: MHz

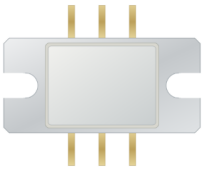
Puissance de sortie saturée: Minimum: 50; Typique: 51; Unité: dBm

Gain en puissance: Minimum: 8; Typique: 9; Unité: dB

Rendement en puissance ajoutée: Typique: 38; Unité: %

Vd = +28 V; Vg = -3 V; PW = 100 µs; D = 10%; Pin = 42 dBm

Détails du produit Fiche technique produit



LCT-2000-6000-PO45p51T

2000–6000 MHz GaN Transistor de puissance à adaptation interne — Pout 45.51 dBm @ 6000 MHz (typique)

2000–6000 MHz; Puissance de sortie de référence 45.51 dBm (typique); Gain en puissance 19.51 dB (typique); Rendement de drain 39.82 % (typique) @ 6000 MHz.

Fréquence de fonctionnement: Symbole: f; Minimum: 2000; Maximum: 6000; Valeur: 2000–6000; Unité: MHz

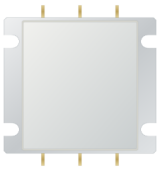
Puissance de sortie de référence: Typique: 45.51; Unité: dBm; Remarques: f = 6000 MHz

Gain en puissance: Typique: 19.51; Unité: dB; Remarques: f = 6000 MHz

Rendement de drain: Symbole: ηD; Typique: 39.82; Unité: %; Remarques: f = 6000 MHz

TA = +25 °C; VDS = 28 V; IDQ = 1.3 A; CW; f = 6000 MHz; Pin = 26 dBm

Détails du produit Fiche technique produit



LCT-700-6200-PS49T

700–6200 MHz GaN Transistor de puissance à adaptation interne — PSAT 49 dBm @ 6000 MHz (typique)

700–6200 MHz; Puissance de sortie saturée 49 dBm (typique); Gain en puissance 7 dB (typique); Rendement de drain 35 % (typique) @ 6000 MHz.

Fréquence de fonctionnement: Symbole: f; Minimum: 700; Maximum: 6200; Valeur: 700–6200; Unité: MHz

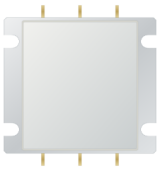
Puissance de sortie saturée: Symbole: Psat; Typique: 49; Unité: dBm; Remarques: f = 6000 MHz

Gain en puissance: Typique: 7; Unité: dB; Remarques: f = 6000 MHz

Rendement de drain: Symbole: ηD; Typique: 35; Unité: %; Remarques: f = 6000 MHz

TA = +25 °C; VDS = 28 V; IDQ = 1 A; CW; f = 6000 MHz

Détails du produit Fiche technique produit



LCT-2000-6200-PO50p1T

2000–6200 MHz GaN Transistor de puissance à adaptation interne — Pout 50.1 dBm @ 6000 MHz (typique)

2000–6200 MHz; Puissance de sortie de référence 50.1 dBm (typique); Gain en puissance 8.6 dB (typique); Rendement de drain 52.4 % (typique) @ 6000 MHz.

Fréquence de fonctionnement: Symbole: f; Minimum: 2000; Maximum: 6200; Valeur: 2000–6200; Unité: MHz

Puissance de sortie de référence: Typique: 50.1; Unité: dBm; Remarques: f = 6000 MHz

Gain en puissance: Typique: 8.6; Unité: dB; Remarques: f = 6000 MHz

Rendement de drain: Symbole: ηD; Typique: 52.4; Unité: %; Remarques: f = 6000 MHz

TA = +25 °C; VDS = 28 V; IDQ = 0.5 A; CW; f = 6000 MHz; Pin = 41.5 dBm

Détails du produit Fiche technique produit

Avis relatif au document

Les spécifications peuvent être révisées. Avant de figer la conception, confirmez auprès de LCRF la révision en vigueur et les exigences

propres au produit. L’offre approuvée et les documents de commande définissent la configuration fournie.